PRESSEMITTEILUNG



Lumcore verlässt sich bei Hochleistungslasern auf Anlagen von AIXTRON

Bestellung über MOCVD-Anlagen zur Herstellung von GaAs- und InPbasierten Epi-Wafern / Hohe Produktausbeute / Niedrige Produktionskosten

Herzogenrath, 19. November 2020 – Lumcore Optoelectronics Technology verlässt sich auf das MOCVD-System <u>AIX 2800G4-TM</u> von AIXTRON SE (FWB: AIXA), einem weltweit führenden Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, um seine Unternehmensentwicklung entscheidend voranzutreiben. "Wir bei Lumcore machen jetzt den nächsten wichtigen strategischen Schritt in der Unternehmensentwicklung, um unseren Kunden weltweit ausgezeichnete Produkte anbieten zu können. Dazu brauchen wir zuverlässige Partner mit exzellenter Technologie an unserer Seite", sagt Xu Tianyou aus China, Vorsitzender von Lumcore, dem chinesischen Spezialisten für Hochleistungslaser auf der Basis von Halbleiterverbindungen.

"AIXTRONs Kerntechnologie sind Epitaxie-Anlagen für das Wachstum von hochwertigen Verbindungs-Halbleitermaterialien. Sie werden von Branchenexperten und technischen Spezialisten weltweit geschätzt. Nach unserer Einschätzung ist das AIXTRON-Produkt die weltweit führende Anlage für die Herstellung von Epitaxie-Materialien für High-End-Halbleiterlaser. Mit äußerst wettbewerbsfähigen Hochleistungslasern können wir einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Entwicklung Chinas leisten", fügt er hinzu.

Beste Homogenität bei der Abscheidung

Mit dem AIX 2800G4-TM-System hat sich Lumcore für AIXTRON-Anlagen entschieden, die speziell für die Herstellung von Gallium-Arsenid- und Indium-Phosphid-Halbleiterkristallstrukturen ausgelegt sind. Die beiden Halbleiterverbindungen GaAs und InP eignen sich besonders für optoelektronische Komponenten wie Hochleistungslaserdioden. Diodenlaser werden zur Materialbearbeitung, zum Schweißen, Schneiden und zur additiven Fertigung verschiedener Materialien eingesetzt. Sie werden darüber hinaus zur optischen Kommunikation über Lichtwellenleiter oder für die 3D-Sensorik wie die Gesichtserkennung in Smartphones oder zur schnellen und präzisen räumlichen Erfassung der Umgebung in autonomen Fahrzeugen verwendet.

Für die Herstellung dieser speziellen Epi-Wafer werden die notwendigen Chemikalien in einem speziellen Verfahren mit Hilfe eines Trägergases radial in die Reaktorkammer Planetenreaktoren-Technologie® von AIXTRON injiziert. Dadurch wird die gewünschte Gleichmäßigkeit des Kristallwachstums und die erforderliche hohe chemische Effizienz

PRESSEMITTEILUNG



ermöglicht. Darüber hinaus ist die Ausbeute, also die Anzahl der verwendbaren Bauelemente pro Wafer, in der AIXTRON-Anlage optimal, sodass Lumcore eine hohe Produktivität bei niedrigen Betriebskosten erreicht. Das kommt wiederum der Marktposition des Spezialisten für Hochleistungslaser auf der Basis von Halbleiterverbindungen zugute.

Epi-Wafer für Zukunftstechnologien

Nicht zuletzt verfügen die AIX 2800G4-TM-Systeme über eine Prozesskammer aus Graphit und eine automatisierte Satellitenbeladung bei hohen Temperaturen, die einen sehr hohen Durchsatz und eine extrem niedrige Partikelanzahl gewährleisten. Die hohe Flexibilität ermöglicht es Lumcore außerdem, je nach Anforderung Epi-Wafer von 2 bis 8 Zoll herzustellen.

Dr. Felix Grawert, Vorstand der AIXTRON SE: "Mit unserer Planetenreaktor-Technologie[®] bieten wir auch für die sehr anspruchsvolle Großserienfertigung eine überzeugende Lösung. Sie zeichnet sich durch hohe Produktivität und Leistungsgewinne bei niedrigen Betriebskosten aus. Mit den auf unseren Systemen gewachsenen Epi-Wafern sind unsere Kunden gut gerüstet für den wachsenden, aber zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Anwendungen von Hochleistungslasern in Bereichen wie Unterhaltungselektronik, Automobil und Kommunikation."

Zum Herunterladen der Fotos klicken Sie bitte hier.

Ansprechpartner

Guido Pickert
Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation
TELEFON +49 (2407) 9030-444
E-MAIL g.pickert@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT $^{(R)}$, AIXTRON $^{(R)}$, APEVA $^{(R)}$, Atomic Level SolutionS $^{(R)}$, Close Coupled Showerhead $^{(R)}$, CRIUS $^{(R)}$, EPISON $^{(R)}$, EPISON $^{(R)}$, Gas Foil Rotation $^{(R)}$, Optacap(TM), OVPD $^{(R)}$, Planetary Reactor $^{(R)}$, PVPD $^{(R)}$, STExS $^{(R)}$, TriJet $^{(R)}$

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Weitere Informationen über Lumcore sind im Internet unter <u>www.lumcore.com</u> verfügbar.

PRESSEMITTEILUNG



Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.